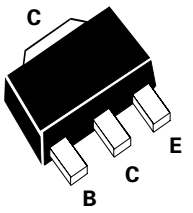
SOT89 NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR

ISSUE 4 – MARCH 2001 ✪

BSR43

COMPLEMENTARY TYPES – BSR33

PARTMARKING DETAIL – AR4



SOT89

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	90	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	80	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	2	A
Continuous Collector Current	I_C	1	A
Base Current	I_B	100	mA
Power Dissipation at T_{amb}=25°C	P_{TOT}	1	W
Operating and Storage Temperature Range	T_j:T_{stg}	-65 to +150	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at T_{amb} = 25°C unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	90		V	I_C=100μA
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	80		V	I_C=10mA *
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5		V	I_E=10μA
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}		100 50	nA μA	V_{CB}=60V V_{CB}=60V, Tamb =125°C
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		0.25 0.5	V V	I_C =150mA, I_B =15mA I_C =500mA, I_B =50mA
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		1.0 1.2	V V	I_C =150mA, I_B =15mA I_C =500mA, I_B =50mA
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	30 100 50	300		I_C =100μA, V_{CE} =5V I_C =100mA, V_{CE} =5V I_C =500mA, V_{CE} =5V
Output Capacitance	C_{obo}		12	pF	V_{CB} =10V, f=1MHz
Input Capacitance	C_{ibo}		90	pF	V_{EB} =0.5V, f=1MHz
Transition Frequency	f_T	100		MHz	I_C=50mA, V_{CE}=10V f =35MHz
Turn-On Time	T_{on}		250	ns	V_{CC} =20V, I_C =100mA I_{B1} =I_{B2} =5mA
Turn-Off Time	T_{off}		1000	ns	

*Measured under pulsed conditions.

For typical characteristics graphs see FMMT493 datasheet.

ZETEX

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9